

	<h2>SIR166DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIR166DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SIR166DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 62567 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIR166DP-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	62567 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 48W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.2 mOhm @ 15A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	77nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3340pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Original-Reel®

SIR166DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SIR166DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIR166DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIR166DP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIR172ADP Vishay Precision Group SIR172ADP VISHAY</p>	 <p>SIR167DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 30V POWERPAK SO-8</p>	 <p>SIR166DP V SIR166DP V</p>	 <p>SIR168DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>
 <p>SIR168DP VB SIR168DP VB</p>	 <p>SIR165DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 30V POWERPAK SO-8</p>	 <p>SIR168DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR166DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ SIR-312STT32	↔ SIR-34ST3F	⇒ SIR-563ST3F	D SIR-563ST3FM	⇒ SIR-563ST3FN
⊖ SIR-563ST3FP	⊕ SIR-563ST3FX	D SIR-56SB3F	⇒ SIR-56ST3F	⇒ SIR-59SSTA47
⊕ SIR11-21C/TR8	⊖ SIR15-21C/TR8	⊕ SIR158DP	↔ SIR158DP-T1-E3	⇒ SIR158DP-T1-GE3
D SIR158DP-T1-GE3	⊕ SIR164ADP-T1-GE3	⊖ SIR164DP	⊕ SIR164DP-T1-E3	⇒ SIR164DP-T1-GE3
⇒ SIR164DP-T1-GE3	↔ SIR166DP	⊕ SIR166DP-T1-E3	⊖ SIR166DP-T1-GE3	⇒ SIR168DP
↔ SIR168DP-T1-GE3	⇒ SIR168DP-T1-GE3	D SIR172ADP-T1-GE3	⊕ SIR172ADP-T1-GE3	⊖ SIR172DP
⊕ SIR172DP-T1-E3	D SIR172DP-T1-GE3	⇒ SIR172DP-T1-GE3	↔ SIR330DP-T1-GE3	⇒ SIR330DP-T1-GE3
⊖ SIR402DP-T1-GE3	⊕ SIR402DP-T1-GE3	↔ SIR403EDP-T1-GE3	⇒ SIR403EDP-T1-GE3	⇒ SIR404DP
⊕ SIR404DP-T1-E3	⊖ SIR404DP-T1-GE3	⊕ SIR404DP-T1-GE3	D SIR406DP	⇒ SIR406DP-T1-E3
↔ SIR406DP-T1-GE3	⊕ SIR406DP-T1-GE3	⊖ SIR406DP-T1-GE3-S	⊕ SIR408DP-T1-GE3	⇒ SIR408DP-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited